



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

HA940

对应国外型号
KSA940

主要用途

功率放大，电视机伴音及帧输出(与 H C2073 互补)

极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T_j ——结温.....	150
P_C ——集电极功率耗散 ($T_a=25^\circ\text{C}$)	1.5W
P_C ——集电极功率耗散 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	25W
V_{CBO} ——集电极—基极电压.....	-150V
V_{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-150V
V_{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I_C ——集电极电流.....	-1.5A
I_B ——基极电流.....	-0.5A

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	150			V	$I_C=500\mu\text{A}$, $I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	150			V	$I_C=10\text{mA}$, $I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	5			V	$I_E=500\mu\text{A}$, $I_C=0$
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			-10	μA	$V_{\text{CB}}=-120\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			-10	μA	$V_{\text{EB}}=-5\text{V}$, $I_C=0$
h_{FE}	直流电流增益	40	75	140		$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			-1.5	V	$I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$
$V_{\text{BE(on)}}$	基极—发射极导通电压	-0.65	-0.75	-0.85	V	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
f_T	特征频率		4		MHz	$V_{\text{CE}}=-10\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容		55		pF	$V_{\text{CB}}=-10\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$

外形图及引脚排列

TO-220

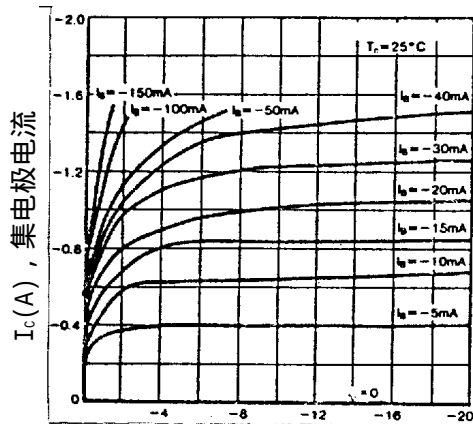


1—基 极 , B
2—集电极 , C
3—发射极 , E



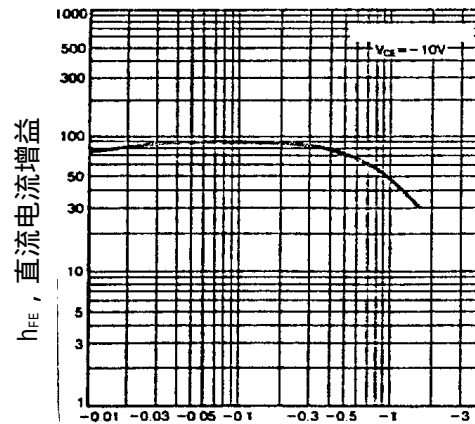
典型特性曲线 (除非另有说明, $T_a=25^\circ\text{C}$)

静态特性

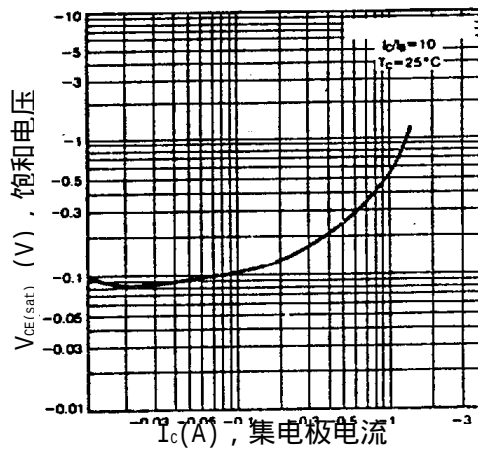


$V_{CE}(V)$, 集电极-发射极电压
集电极-发射极饱和电压

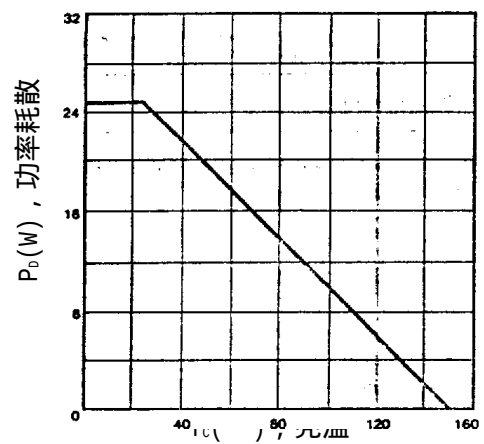
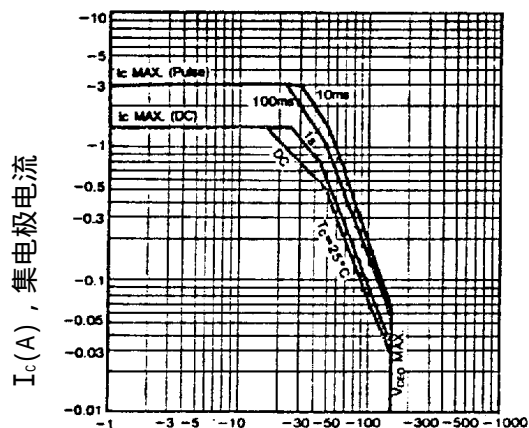
直流电流增益



$I_C(A)$, 集电极电流
功率降额



安全工作区



$V_{CE}(V)$, 集电极-发射极电压